

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年6月30日(2016.6.30)

【公開番号】特開2014-220463(P2014-220463A)

【公開日】平成26年11月20日(2014.11.20)

【年通号数】公開・登録公報2014-064

【出願番号】特願2013-100364(P2013-100364)

【国際特許分類】

H 01 L 21/338 (2006.01)

H 01 L 29/778 (2006.01)

H 01 L 29/812 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/80 H

【手続補正書】

【提出日】平成28年5月10日(2016.5.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の上に設けられた半導体層と、

前記半導体層の上に設けられた電極パッドと、

前記電極パッドと接し、前記電極パッドの上面が露出する第1開口部を有する無機絶縁膜と、

前記無機絶縁膜の上に設けられ、前記電極パッドの上面が露出する第2開口部を有する樹脂膜と、

前記第2開口部と前記基板の端部との間に位置し、その底面が前記樹脂膜または前記無機絶縁膜に位置してなる、少なくとも前記樹脂膜の第3開口部と、を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

前記電極パッドの周縁は、前記第2開口部の内側に位置することを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】

前記第3開口部は、前記無機絶縁膜の上面が露出されてなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項4】

前記樹脂膜はポリイミド、又はベンゾシクロブテンにより形成されていることを特徴とする請求項1から3いずれか一項記載の半導体装置。

【請求項5】

前記無機絶縁膜は窒化シリコンまたは窒化酸化シリコンにより形成されていることを特徴とする請求項1から4いずれか一項記載の半導体装置。

【請求項6】

前記半導体層はFETを形成し、

前記電極パッドは、前記FETのドレインパッドまたはソースパッドであることを特徴とする請求項1から5いずれか一項記載の半導体装置。

【請求項7】

前記電極パッドの上面は金により形成されていることを特徴とする請求項 1 から 6 いす
れか一項記載の半導体装置。